

Technische Information / technical information



**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT2200N18P55

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Key Parameters

V_{DRM} / V_{RRM}	1800 V
$I_{overload(21s)}$	2180 A
I_{TSM}	21000 A
V_{T0}	0,9 V
r_T	0,24 m Ω
$R_{thJA(21s)}$	0,082 K/W



Merkmale

- Druckkontakt-Technologie für hohe Zuverlässigkeit
- Advanced Medium Power Technology (AMPT)
- Integrierter optimierter Kühlkörper

Features


- Pressure contact technology for high reliability
- Advanced Medium Power Technology (AMPT)
- Integrated optimized heatsink

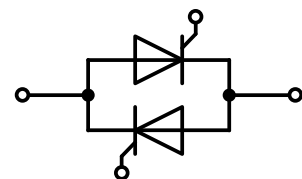
Typische Anwendungen

- Sanftanlasser
- Bypass-Schalter
- Leistungssteller
- Statischer Umschalter

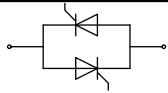
Typical Applications

- Soft starter
- Bypass switch
- Power controller
- Static switch

		
content of customer DMX code	DMX code digit	DMX code digit quantity
serial number	1..5	5
SAP material number	6..12	7
Internal production order number	13..20	8
datecode (production year)	21..22	2
datecode (production week)	23..24	2



www.ifbip.com
support@infineon-bip.com



Technische Information / technical information



**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT2200N18P55

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

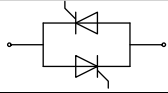
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}^{*1)}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1800	V
Vorwärts- und Rückwärts Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state and reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DSM}}, V_{\text{RSM}}$	1850	V
Überlaststrom overload current	W1C; sin.180°; $t_{\text{overload}} = 21\text{s}$ $T_{vj} = 155^{\circ}\text{C}; T_{vj\text{start}} = 40^{\circ}\text{C}$	I_{overload}	2180	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	I_{TSM}	21.000 17.500	A A
Grenzlastintegral I²t-value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	I²t	2.205.000 1.531.250	A²s A²s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$	250	A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 th letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$	1000	V/ μs

*1.) Reduktionsfaktor von -0,1% pro K für T_{vj} kleiner 25 °C
Derating factor of -0,1% per K for T_{vj} below 25 °C

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, I_{\text{T}} = 2000\text{A}$	V_{T}	max. 1,38	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{(\text{TO})}$	max. 0,9	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	r_{T}	max. 0,24	m Ω
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$	I_{GT}	max. 200	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$	V_{GT}	max. 2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max. 0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}, R_{\text{A}} = 1\Omega$	I_{H}	max. 300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 10\Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20\mu\text{s}$	I_{L}	max. 1200	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom W1C forward off-state and reverse current W1C	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}} + i_{\text{R}}$	max. 240	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 3	μs

prepared by: JS		date of publication: 2020-04-01
approved by: MS		revision: 3.1



Technische Information / technical information



**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT2200N18P55

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$, $v_{DM} = 0,67\text{ V}_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter O	t_q	typ.	250	μs
---	---	-------	------	-----	---------------

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

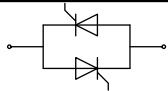
Innerer Wärmewiderstand, Sperrschicht zum Referenzpunkt thermal resistance, junction to reference point	pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$	$R_{thJR(21s)}^{1)}$	max.	0,028	K/W
			max.	0,056	K/W
			max.	0,029	K/W
			max.	0,058	K/W
Innerer Wärmewiderstand, Sperrschicht zur Umgebung thermal resistance, junction to ambient	pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$	$R_{thJA(21s)}$	max.	0,041	K/W
			max.	0,082	K/W
			max.	0,042	K/W
			max.	0,084	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\max}$		125 ²⁾	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+125 ²⁾	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+130	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 4 page 4	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance $\pm 10\%$	M6		10	Nm
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46 244			A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight		G	typ.	1340	g
Kriechstrecke creepage distance				6,3	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$			50	m/s^2

Die Werte der obigen Tabellen sind immer bezogen auf das Einzelelement, falls nicht anders erwähnt.
The values of the above tables are always based on the single element, if not otherwise mentioned.

- 1) Referenzpunkt für R_{thJR} befindet sich stirnseitig an den Modulen (siehe Zeichnung)
Reference point for R_{thJR} is located front of the modules (see drawing)
- 2) Die $T_{vj\max}$ bis 155°C ist für eine maximale Überlastzeit von 21s erlaubt ($T_{vj\max}$ Kurzzeit)
The $T_{vj\max}$ up to 155°C is allowed for a maximum time of overload of 21s ($T_{vj\max}$ short time)



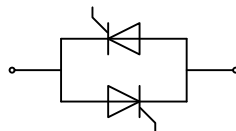
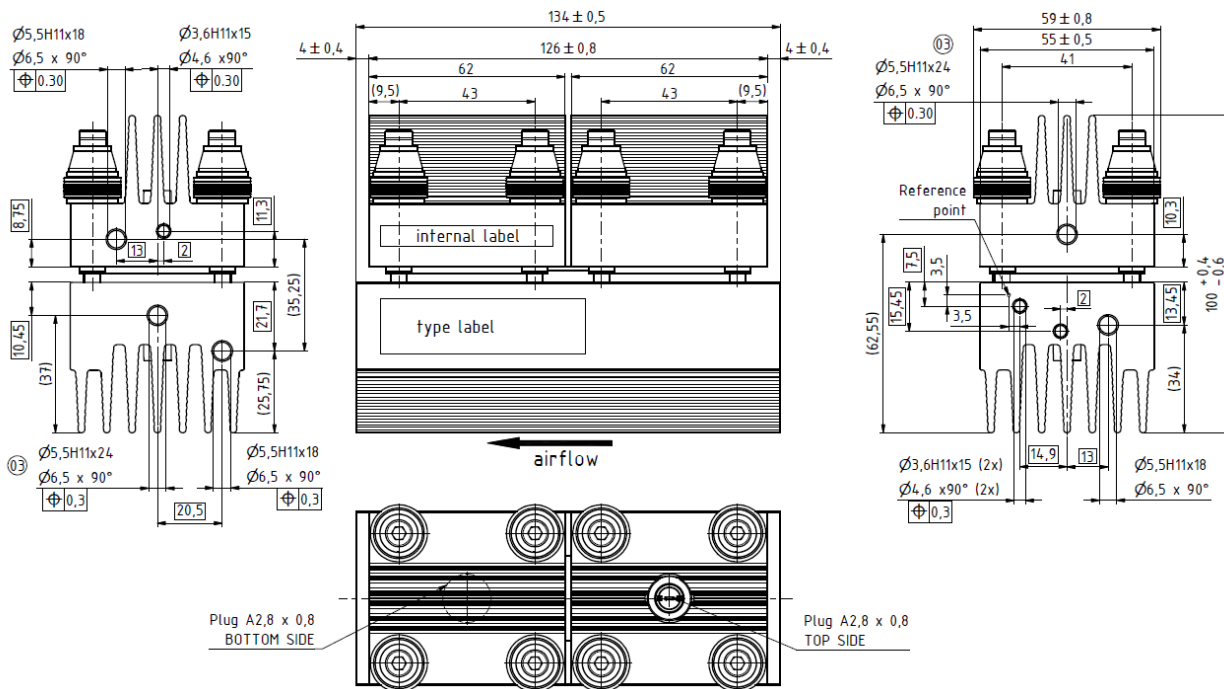
Technische Information /
technical information



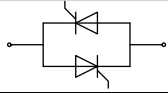
Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module

sTT2200N18P55

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



W1C



Technische Information /
technical information



Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module

sTT2200N18P55

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJA} für DC und $v_{Luft} = 3,6\text{m/s}$
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJA} for DC and $v_{Luft} = 3,6\text{m/s}$

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [K/W]	0,28	0,17	0,0285	0,0135	0,003		
T_n [s]	400	150	2	0,2	0,004		

Analytische Funktion / Analytical function:

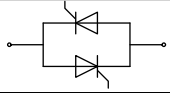
$$Z_{thJA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[1 - e^{-\frac{t}{T_n}} \right]$$

Erhöhung des $Z_{th DC}$ bei Sinusströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln Θ
Rise of $Z_{th DC}$ for sinewave current with different current conduction angles Θ

$\Delta Z_{th \Theta \sin}$

	$\Theta = 180^\circ$	$\Theta = 120^\circ$	$\Theta = 90^\circ$	$\Theta = 60^\circ$	$\Theta = 30^\circ$
$\Delta Z_{th \Theta \sin}$ [K/W]	0,002422	0,0033	0,0047	0,0064	0,0092

$$Z_{th \Theta \sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta \sin}$$



Technische Information /
technical information



Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module

sTT2200N18P55

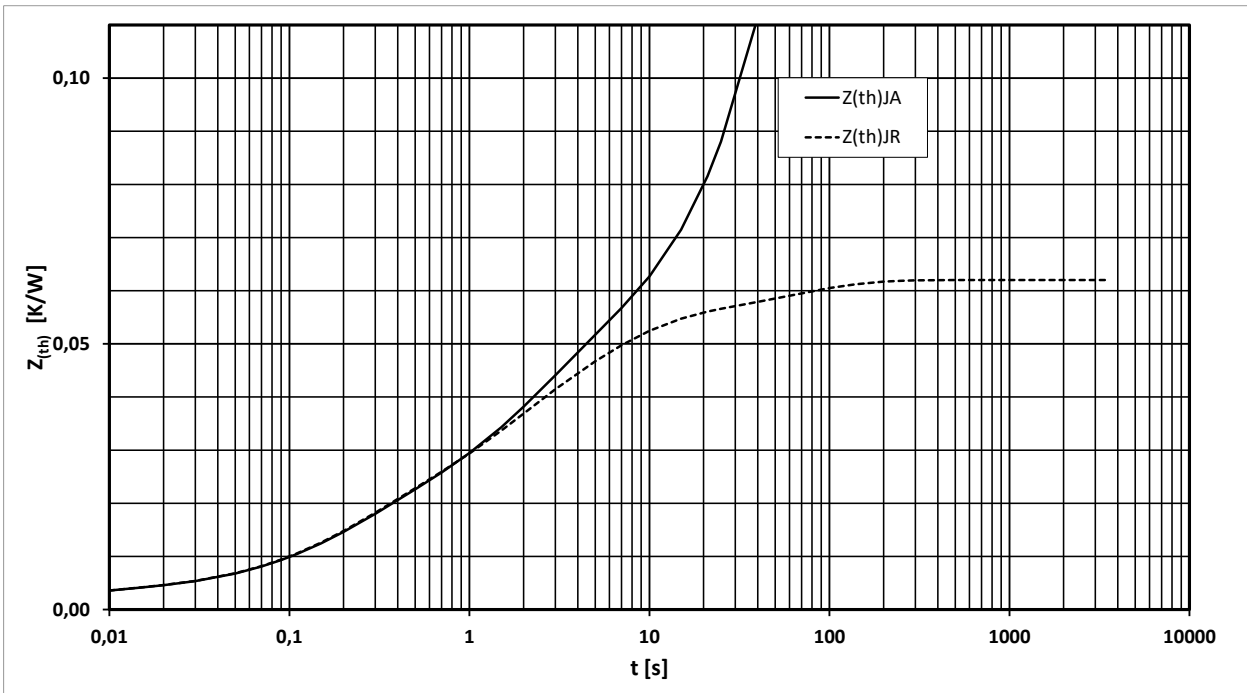
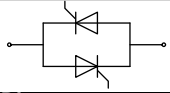
Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJR} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJR} for DC

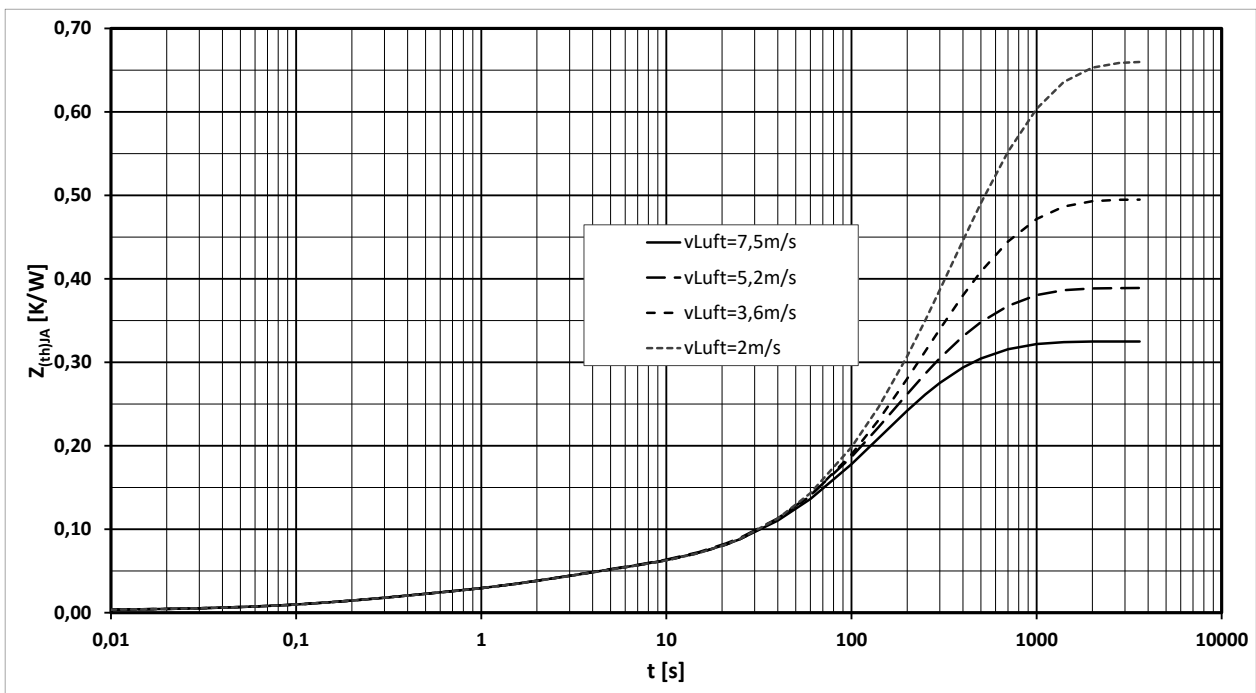
Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [K/W]	0,008	0,0205	0,017	0,0135	0,003		
τ_n [s]	60	5	1,3	0,2	0,004		

Analytische Funktion / Analytical function:

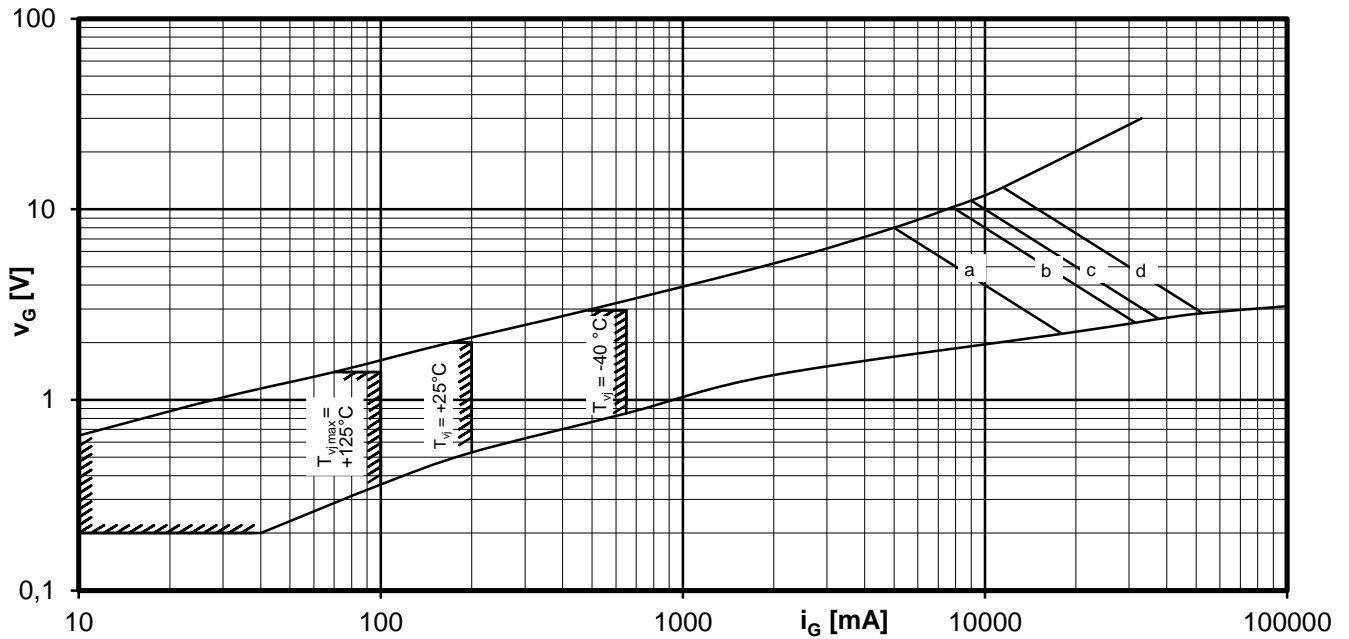
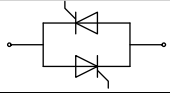
$$Z_{thJR} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right]$$



Transienter Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm
 $Z_{thJR} = f(t)$; $Z_{thJA} = f(t)$



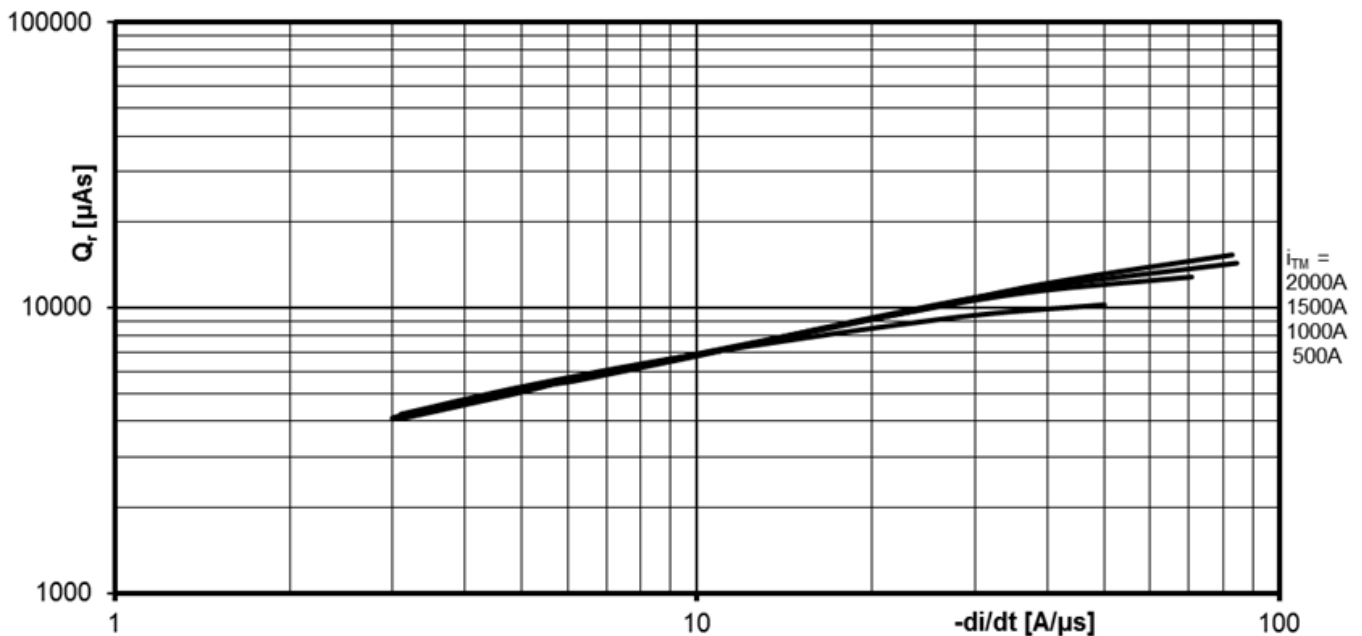
Transienter Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJA} = f(t)$



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12\text{ V}$
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

a - 40W/10ms b - 80W/1ms c - 100W/0,5ms d - 150W/0,1ms



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}